

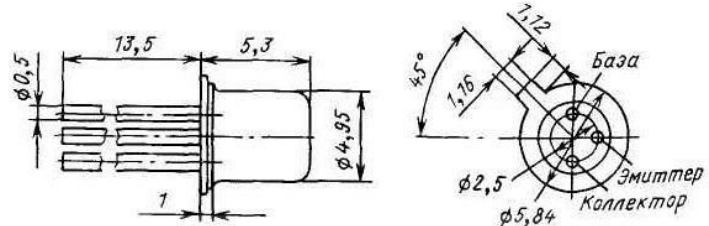
KT501A, KT501Б, KT501В, KT501Г, KT501Д, KT501Е, KT501Ж, KT501И, KT501К, KT501Л, KT501М

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p усилительные низкочастотные маломощные

Предназначены для применения в усилителях низкой частоты с нормированным коэффициентом шума, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах

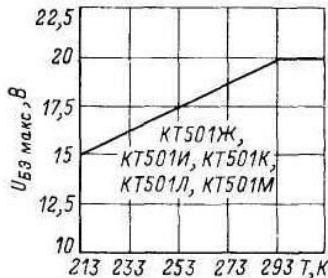
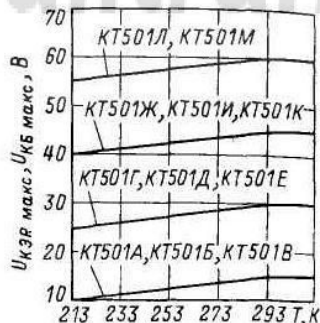
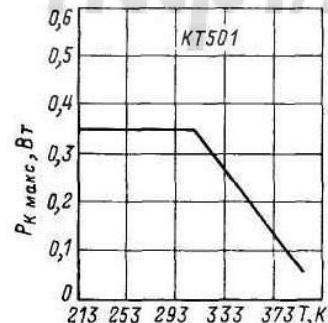
Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора не более 0,6 г



Примечание При включении транзистора в цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт присоединяется первым и отключается последним

Расстояние от места изгиба до корпуса транзистора не менее 3 мм с радиусом закругления 1,5–2 мм Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора



Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры

Зависимости максимально допустимых напряжений коллектор-эмиттер и коллектор-база от температуры

Зависимость максимально допустимого напряжения база-эмиттер от температуры

Электрические параметры

Коэффициент шума при $U_{KE} = 3 В$ $I_K = 0,2 мА$, $R_T = 3 кОм$ $f = 1 кГц$ не более	4 дБ
Типовое значение	2* дБ
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более	
при $I_K = 0,3 А$, $I_B = 0,06 А$	0,4 В
при $I_{Kи} = 0,5 А$, $I_B = 0,1 А$	0,7 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,3 А$, $I_B = 0,06 А$ не более	1,5 В
Статистический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером	
при $U_{KЭ} = 1 В$, $I_K = 30 мА$	
KT501А KT501Г, KT501Ж, KT501Л	20 – 60
KT501Б KT501Д KT501И, KT501М	40 – 120
KT501В, KT501Е, KT501К	80 – 240
при $U_{KЭ} = 1 В$, $I_{Kи} = 0,5 А$ не менее	6
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KЭ} = 5 В$ $I_K = 10 мА$ не менее	5 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10 В$, $f = 500 кГц$ не более	50 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 0,5 В$, $f = 500 кГц$ не более	100 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КЭР} = U_{КЭР макс}$ $R_{БЭ} = 10 кОм$ не более	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = U_{БЭ макс}$ не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор-база и коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 кОм$ $T = 298 – 398 К$	
KT501А KT501Б, KT501В	15 В
KT501Г KT501Д, KT501Е	30 В
KT501Ж KT501И, KT501К	45 В
KT501Л KT501М	60 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $T = 213 – 398 К$ (при $T = 298 – 398 К$ KT501Ж, KT501И, KT501К, KT501Л, KT501М)	
KT501А KT501Б, KT501В, KT501Г, KT501Д, KT501Е	10 В
KT501Ж, KT501И, KT501К, KT501Л, KT501М	20 В
Постоянный ток коллектора при $T = 213 – 398 К$	0,3 А
Импульсный ток коллектора при $T = 213 – 398 К$	0,5 А
Постоянный ток базы при $T = 213 – 398 К$	0,1 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 213 – 308 К$	0,35 Вт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К